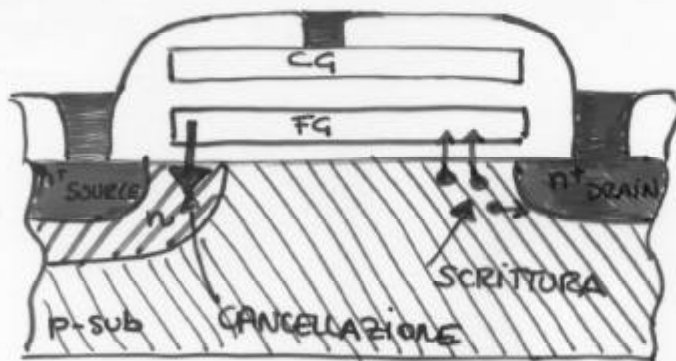


* MEMORIE FLASH

Sono memorie ROM scrivibili e cancellabili elettricamente
(POSSONO ESSERE CANCELLATE SOLO A BLOCCHI, NON SINGOLI BIT)
e si basano su Transistori MOS a doppio gate



- PROGRAMMAZIONE: come nelle EPROM vi è iniezione di elettroni caldi (HOT ELECTRON) per valanga in prossimità del drain
↳ FG immagazzina la carica impedendo la formazione del canale \Rightarrow livello logico '0'
 - CANCELLAZIONE: CG è polarizzato negativamente ed il source è polarizzato positivamente
↳ TUNNELING di elettroni da FG attraverso l'ossido di Tunnel verso la regione poco drogata di source.
La cella vergine o cancellata (livello '1') consente la formazione del canale quando è applicata la tensione positiva di esercizio a CG.
- d'operazione di cancellazione è abbastanza lenta (decine di s)
Sono possibili 10'000 - 100'000 cancellazioni -
MEMORIE NON VOLATILI: affidabilità dell'informazione memorizzata per 10 anni \Rightarrow posso "perdere" 1 elettrone al giorno.